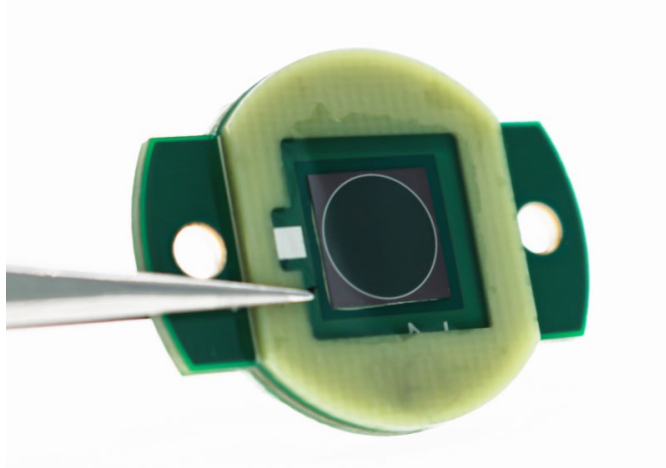




8mm大光敏面（Si）硅光电探测器



产品描述:

器件为硅PIN 光电二极管，在反向偏置条件下工作。峰值波长在 940nm 左右,光谱探测范围从 400nm~1100nm。

产品特点:

-  平面正照结构
-  快速响应
-  低暗电流
-  高响应度
-  高可靠性

产品应用:

-  分布式光纤传感
-  激光测风雷达
-  光电倍增管放大器
-  自动测量系统
-  ADC前置放大器

参数		符号	测试条件	典型值											单位		
光敏面尺寸				Φ0.2	Φ0.5	Φ1	Φ2	Φ5	Φ8	0.5X0.5	1X1	1.3X1.3	2X2	3X3	mm		
光参数	光谱响应范围	λ		400~1100											nm		
	响应度	Re	VR=15V, λ=900nm	0.40	0.45	0.5	0.5	0.5	0.55	0.45	0.45	0.5	0.5	0.5	A/W		
	响应时间	tr	VR=15V, RL=50Ω	2	5	6	8	15	25	3.5	5	8	10	15	ns		
电参数	暗电流	ID	VR=15V	1	2	3	2	40	60	3	3	4	6	10	nA		
	反向击穿电压	VBR	IR=10μA	100						50	80				V		
	电容	Cj	f=1MHz, VR=15V	0.8	1.2	2.0	6	30	70	6.0	3	3	10	25	pF		
工作电压		VR		0~15													V
管座型号				同轴Ⅱ型、5501、 TO46、插拔式、 带尾纤			T0-5	TO-8		同轴Ⅱ型、5501、 TO46、插拔式、 T05			T0-5				
饱和光功率 0.3w/cm ²																	

*器件的光敏面尺寸及技术指标可根据用户的使用要求而定;具体参数及器件管壳使用引脚详见产品附带参数表.

注意事项

该器件在反向偏置电压下工作,注意器件极性不能接反。

光纤弯曲度不能小于 45 度。

器件在贮运、使用中注意静电防护措施。